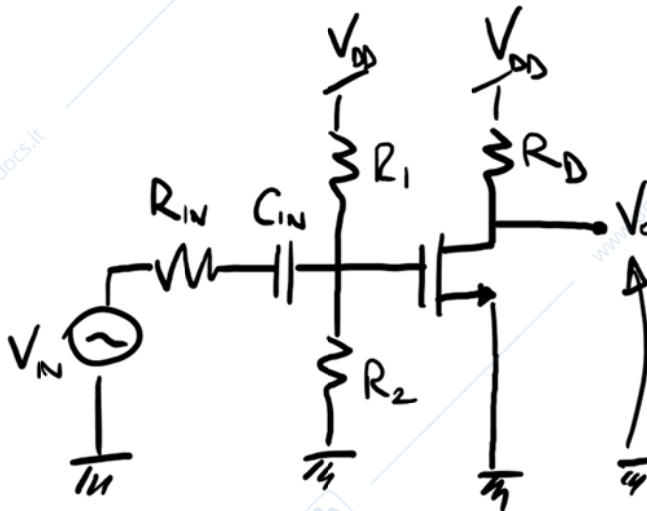


Fondamenti di Elettronica per Ingegneria dell'Automazione

Esercitazione 6

Ing. Pietro King

1)



$$V_{dd} = +12 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_{in} = 100 \text{ pF}$$

$$V_{tn} = 1 \text{ V}$$

$$k_n = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

- Calcolare la polarizzazione del circuito
- Calcolare il guadagno $\frac{v_{out}}{v_{in}}$
- Nel caso ad alta frequenza, calcolare il massimo valore dell'ampiezza applicabile in ingresso affinché la condizione di piccolo segnale per il MOS sia rispettata.

Il circuito rappresenta un Amplificatore MOSFET, ovvero un circuito che è in grado di dare in uscita (v_{out}) un segnale amplificato e proporzionale al segnale di ingresso (v_{in}).

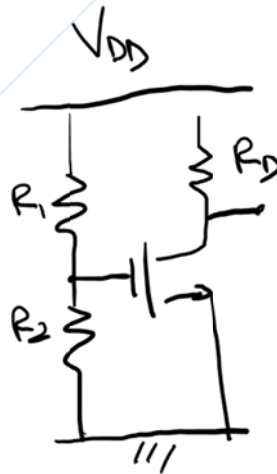
Un MOSFET può essere utilizzato come amplificatore se opera in zona di saturazione.

Per questo motivo è necessario che siano presenti dei generatori di polarizzazione, ovvero generatori di tensione o corrente che consentono al MOSFET di rimanere in zona di saturazione.

a)

Per determinare la polarizzazione del circuito, procedo considerando innanzitutto il circuito con tensione d'ingresso nulla ($V_{in} = 0\text{V}$).

In questa situazione tutte le tensioni sono costanti, quindi posso considerare il condensatore come un circuito aperto.



La corrente di Gate del MOS è nulla, quindi R_1 e R_2 sono in serie. Posso calcolare V_G come partitore di tensione.

$$V_G = 12V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12V \frac{200 \text{ k}\Omega}{1200 \text{ k}\Omega} = 2V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2V - 0V = 2V$$

$$V_{GS} = 2V > 1V = V_{tn}$$

$V_{GS} > V_{tn}$, quindi il MOSFET è acceso.

Ipotizziamo SATURAZIONE:

$$Hp: V_{DS} > V_{GS} - V_{tn}$$

$$I_D = k (V_{GS} - V_{tn})^2 = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} (2 - 1)^2 = 1 \text{ mA}$$

$$V_{RD} = I_D R_D = 1 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 4V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - V_{RD} - 0V = 12V - 4V = 8V$$

Ora verifico che l'ipotesi sia corretta:

$$V_{DS} = 8V > 1V = V_{GS} - V_{tn}$$

Abbiamo dimostrato che il MOSFET è in SATURAZIONE.

Quando un MOSFET funziona in zona di saturazione, questo si comporta come un generatore di corrente comandato in tensione. Infatti, è possibile controllare la corrente I_D come funzione della tensione V_{GS} :

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_t)^2$$

Introduciamo un nuovo fattore di qualità del dispositivo, chiamato **TRANSCONDUUTTANZA**, che indica quanto varia I_D per una variazione infinitesima di V_{GS} :

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{i_d}{v_{gs}} = 2 k_n (V_{GS} - V_t) = 2 \sqrt{k_n I_D}$$

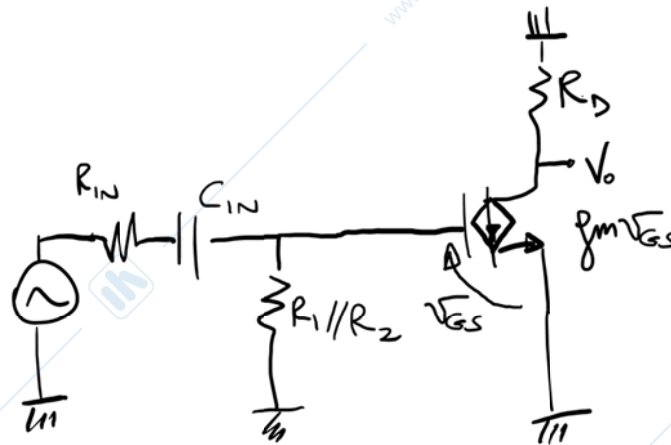
La relazione lineare tra i segnali $i_d = g_m v_{gs}$ e' il risultato di aver linearizzato la caratteristica $I_D = k_n (V_{GS} - V_t)^2$ intorno al punto di lavoro (I_D, V_{GS}) calcolato sopra, ed e' valida sotto la condizione di "piccolo" segnale $|v_{gs}| \ll 2(V_{GS} - V_t)$.

Nel nostro caso

$$g_m = 2 k_n (V_{GS} - V_t) = 2 \cdot 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 1 \text{V} = 2 \text{m}\Omega^{-1}$$

b)

Per il calcolo del guadagno $G = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ passo al circuito per piccolo segnale, in cui spengo tutti i generatori di tensione e corrente indipendenti, e in cui sostituisco il MOS col suo equivalente per piccoli segnali, ovvero un generatore di corrente comandato in tensione $i_d = g_m v_{gs}$.



Ci ricordiamo che il concetto di guadagno ha senso solo per i circuiti lineari, ed effettivamente il circuito equivalente per piccoli segnali (come si vede sopra) e' lineare.

Prima di tutto calcoliamo il guadagno a frequenza nulla.

$f = 0$:

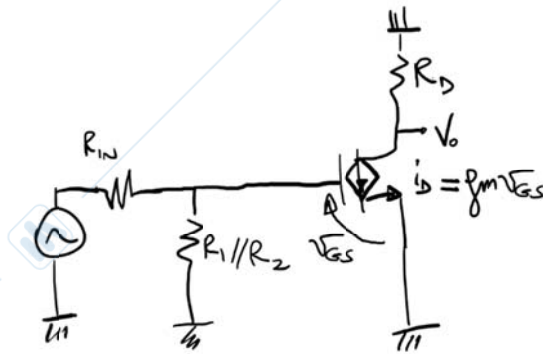
Se siamo a frequenza nulla, il condensatore si comporta come un circuito aperto. Quindi il contributo dovuto al segnale d'ingresso e' nullo. Quindi:

$$|G(0)| = 0$$

Poi possiamo calcolare il guadagno a frequenza infinita.

$f = \infty$:

A frequenza infinita, il condensatore si comporta come un cortocircuito:



In questo caso

$$v_{out} = -i_d R_D$$

$$i_d = g_m v_{gs}$$

v_{gs} si può ottenere dal partitore tra R_{in} e $R_1//R_2$:

$$v_{gs} = V_{in} \frac{R_1//R_2}{R_{in} + R_1//R_2} \approx 0.95 v_{in}$$

Quindi

$$v_{out} = -i_d R_D = -g_m 0.95 v_{in} R_D$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m 0.95 R_D = -2 \text{ m}\Omega^{-1} 0.95 4 \text{ k}\Omega = -7.6$$

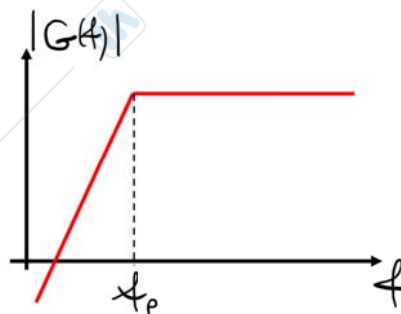
$$|G(\infty)| = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}}(\infty) \right| = 7.6 = 20 \log(7.6) \text{ dB} = 17.6 \text{ dB}$$

Determinati il guadagno a frequenza nulla e infinita, e' necessario determinare la frequenza del polo introdotto dalla capacità C_{in} , oltre allo zero introdotto nello 0. Tale frequenza e' legata alla costante di tempo caratteristica, ovvero il prodotto tra la capacità e la resistenza equivalente "vista" ai suoi capi.

$$R_{eq} = R_{in} + R_1//R_2 = 10 \text{ k}\Omega + 166 \text{ k}\Omega = 176 \text{ k}\Omega$$

$$\tau_{polo} = R_{eq} C_{in} = 176 \text{ k}\Omega 100 \text{ pF} = 17.6 \mu\text{s}$$

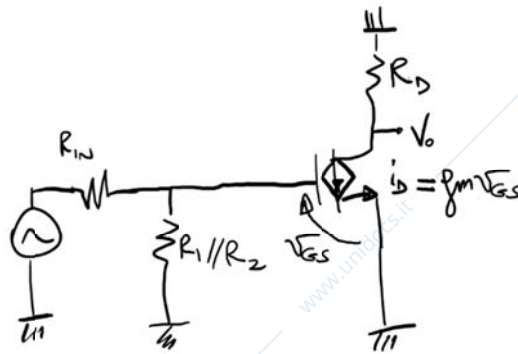
$$f_{polo} = \frac{1}{2\pi \tau_{polo}} = 9 \text{ kHz}$$



c)

Nei punti precedenti abbiamo applicato il modello a piccoli segnali, che ci permette di considerare la risposta del sistema lineare fintanto che il segnale di ingresso è "abbastanza piccolo" da non uscire dal suo punto di lavoro.

Ovvero, noi possiamo considerare $i_d = g_m v_{gs}$, fintanto che $v_{GS} \ll 2(V_{GS} - V_{tn}) = 2 * V_{OV}$, ovvero se il segnale v_{GS} tra gate e source è molto più piccolo di due volte la tensione di overdrive di polarizzazione. Solitamente si considera almeno un fattore 10 di margine.



Nel circuito sotto esame

$$v_{gs} = v_{in} \frac{R_1 // R_2}{R_{in} + R_1 // R_2} \approx 0.95 v_{in}$$

Quindi possiamo scrivere:

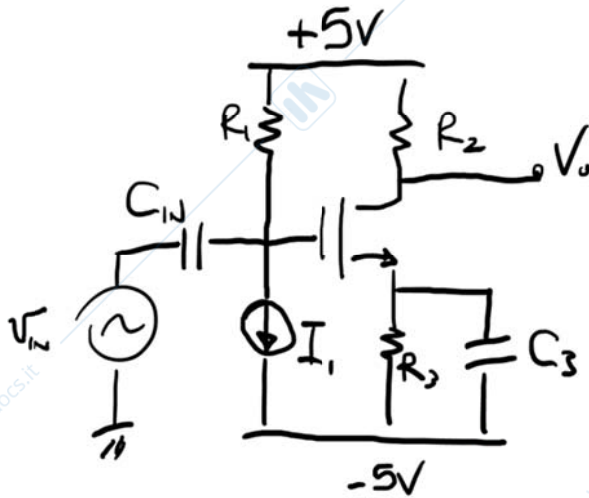
$$|v_{GS}| = 0.95 |v_{in}| \ll 2 * |V_{GS} - V_{tn}| = 2 * 1V = 2V$$

$$|v_{in}| \ll \frac{2V}{0.95} = 2.10 V$$

Quindi la condizione di piccolo segnale è verificata per

$$|v_{in}| < 210 mV$$

2)



$I_1 = 1\text{mA}$

$R_1 = 4\text{ k}\Omega$

$R_2 = 4\text{ k}\Omega$

$R_{in} = 10\text{ k}\Omega$

$C_3 = 100\text{ pF}$

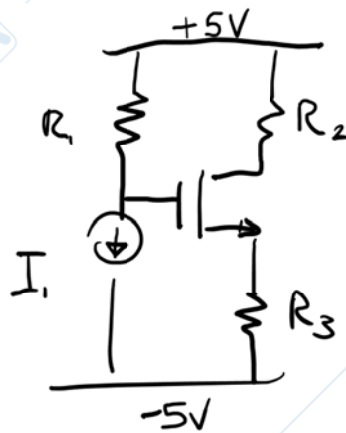
$C_{in} \gg C_3$

$V_{tn} = 1\text{ V}$

$k_n = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

a) Dimensionare R_3 tale per cui il transistor sia in saturazione e $I_D = 1\text{mA}$

Consideriamo $v_{in} = 0$ e C_{in} aperta.



$V_{R1} = I_1 R_1 = 1\text{mA} \cdot 4\text{k}\Omega = 4\text{V}$

$V_G = 5 - V_{R1} = 5 - 4 = 1\text{V}$

HP: Saturazione

$I_D = k(V_{GS} - V_t)^2$

$$V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{I_D}{k_n}} = \sqrt{\frac{1\text{mA}}{1\frac{\text{mA}}{\text{V}^2}}} = 1\text{V}$$

$V_{GS} = 2\text{V}$

$$V_S = V_G - V_{GS} = -1V$$

Conoscendo V_{source} possiamo dimensionare R_3

$$R_3 = \frac{V_{R3}}{I_{R3}} = \frac{V_S - (-5V)}{I_D} = \frac{-1V + 5V}{1mA} = 4k\Omega$$

Verifico la saturazione

$$V_{R2} = I_D R_2 = 4k\Omega \cdot 1mA = 4V$$

$$V_D = 5V - 4V = +1V$$

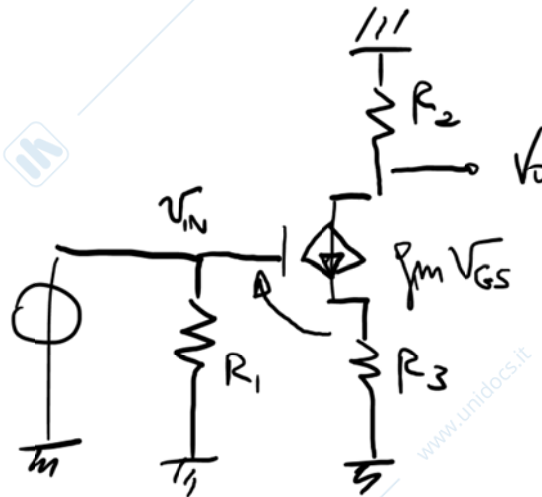
$$V_{DS} = 2V > 1V = V_{OV}$$

Saturazione verificata

$$g_m = 2 k_n (V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 1 \frac{mA}{V^2} \cdot 1V = 2 m\Omega^{-1}$$

b) Assumendo C_{in} chiusa, determinare $|G(0)|$ e $|G(\infty)|$

$|G(0)|$



$$i_D = g_m v_{GS}$$

$$v_{out} = -i_D R_2 = -g_m v_{GS} R_2$$

$$v_{GS} = v_{in} - i_D R_3 = v_{in} - g_m v_{GS} R_3$$

$$v_{GS}(1 + g_m R_3) = v_{in}$$

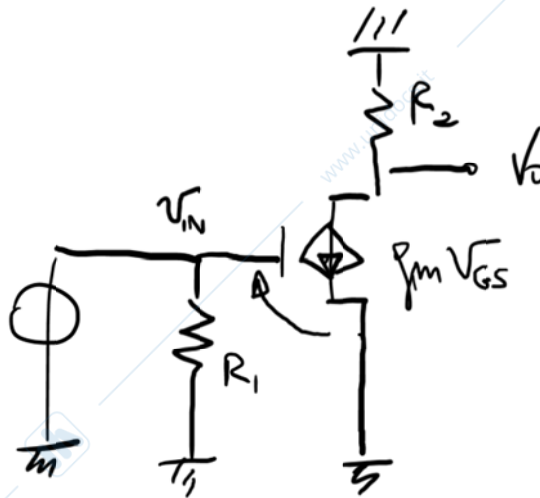
$$v_{GS} = \frac{v_{in}}{(1 + g_m R_3)}$$

$$v_{out} = -g_m v_{GS} R_2 = -g_m R_2 \frac{v_{in}}{(1 + g_m R_3)}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_2 \frac{1}{(1 + g_m R_3)} = -2\text{mS} \cdot 4\text{k}\Omega \frac{1}{1 + 2\text{mS} \cdot 4\text{k}\Omega} = -\frac{8}{9}$$

$$|G(0)| = \frac{8}{9} = 0.88$$

$|G(\infty)|$



$$v_{out} = -g_m V_{GS} R_2$$

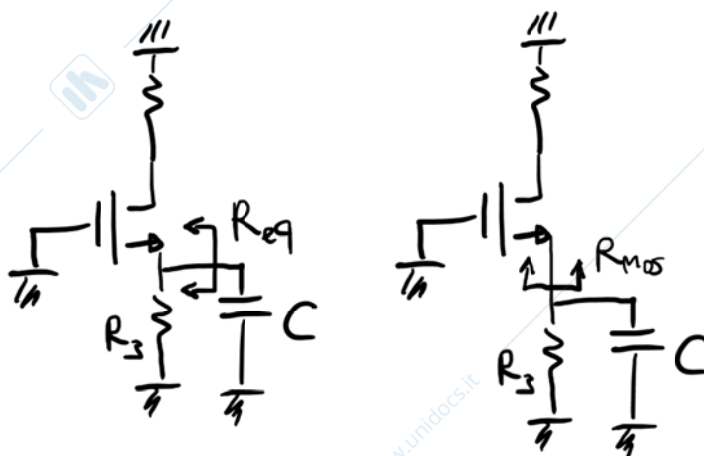
$$v_{out} = -g_m V_{in} R_2$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_2 = -8$$

$$|G(\infty)| = 8$$

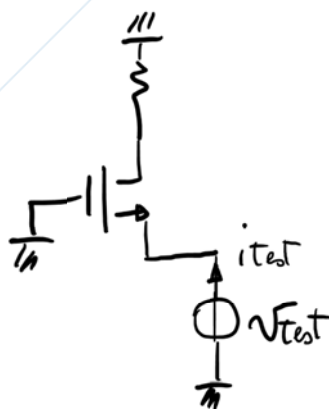
c) *Frequenza di poli e zeri.*

Studiamo il polo introdotto da C3



$$R_{eq} = R3 // r_{mos}$$

Per calcolare rmos dobbiamo calcolare la resistenza thevenin vista da quel punto



$$i_d = g_m v_{GS}$$

$$i_d = -g_m v_t$$

$$i_d = -i_t$$

$$r_{mos} = \frac{v_t}{i_t} = 1/g_m$$

$$R_{eq} = R3 // \frac{1}{g_m} = 440 \Omega$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_{eq} C3} = 3.58 \text{ MHz}$$

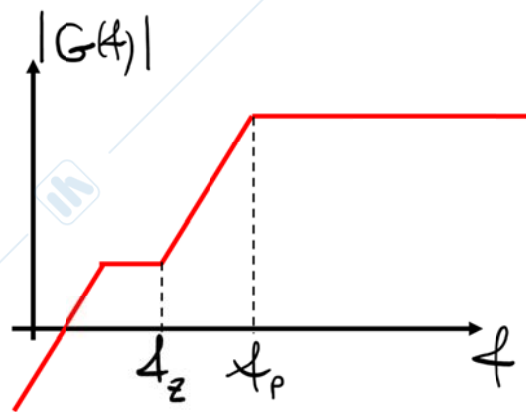
Lo zero di C3 lo possiamo trovare come $|G(0)| \frac{1}{f_z} = |G(\infty)| \frac{1}{f_p}$

$$f_z = f_p \frac{8}{9} \frac{1}{8} = \frac{f_p}{9} = 398 \text{ kHz}$$

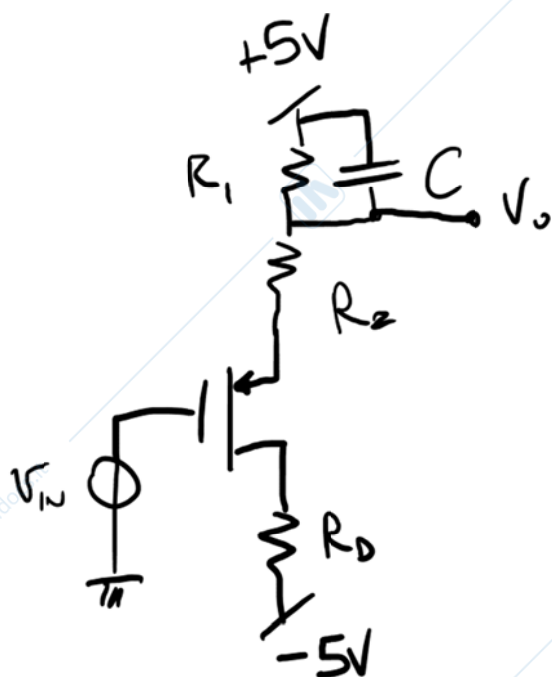
Per tracciare il diagramma di Bode complessivo, valutiamo anche le singularita' introdotte da C_{in}.

Le due capacita' C_{in} e C₃ sono "separate" e ciascuna da' luogo ad un polo, in ragione della resistenza equivalente vista ai loro capi, e uno zero. C_{in} introduce uno zero a f=0 (dato che a f=0 C_{in} si apre) e un polo a bassa frequenza (f_{in}). Essendo C_{in} >> C₃ consideriamo il polo di C_{in} a frequenza molto piu' bassa delle singularita' introdotte da C₃, il che giustifica i calcoli fatti finora con C_{in} chiusa. Per frequenze f >> f_{in} siamo nella condizione in cui la capacita' C_{in} sia da considerarsi chiusa e C₃ sia ancora aperta, che conduce al guadagno che abbiamo denominato |G(0)|. Ad alta frequenza, dopo le singularita' introdotte da C₃, anche C₃ puo' essere considerata chiusa e si avra' il guadagno |G(∞)|.

[Se volessimo valutare la costante di tempo del polo di C_{in}, la introduciamo nel circuito equivalente per piccoli segnali e spegniamo il generatore di segnale in ingresso (v_{in}=0). La resistenza equivalente e' semplicemente R₁].



3)



$$R1 = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 0.5 \text{ k}\Omega$$

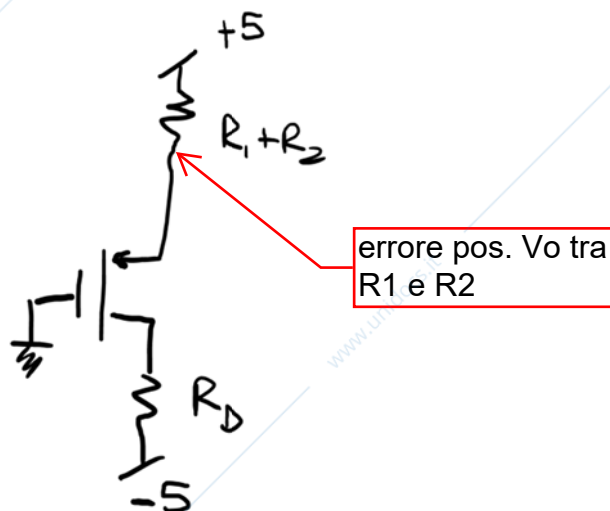
$$RD = 3 \text{ k}\Omega$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$V_{tp} = -1 \text{ V}$$

$$k_p = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

a) Polarizzazione



HP SAT

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$5V - I_D(R1 + R2) + V_{GS} = 0$$

$$I_D = \frac{5V + V_{GS}}{R1 + R2} = \frac{5V + V_{GS} - V_t + V_t}{R1 + R2}$$

$$(x = V_{GS} - V_t)$$

Uguagliando le due espressioni di I_D

$$k x^2 = \frac{5V + x + V_T}{R_1 + R_2}$$

$$3x^2 - x - 4V = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 48}}{6} = \frac{1 \pm 7}{6} = \begin{cases} 1.3 V \\ -1 \end{cases}$$

Per l'ipotesi di pMOS in Saturazione deve essere che $V_{GS} - V_t < 0$, quindi:

$$V_{GS} - V_t = -1V$$

$$V_{GS} = -2V$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 = 1mA$$

$$V_{DS} = -I_D(R_1 + R_2 + R_D) = -1mA \cdot 6k = -6V$$

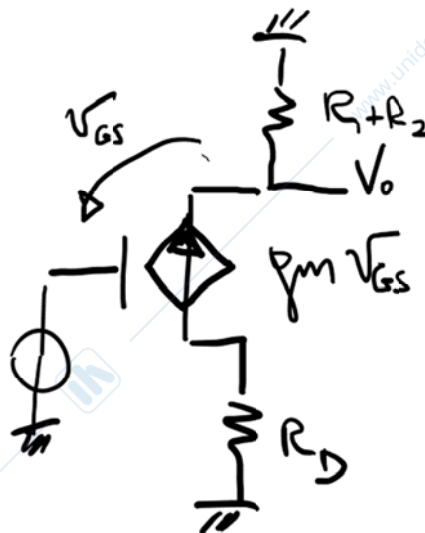
$$V_{DS} = -6V < -1V = V_{GS} - V_t$$

Saturazione confermata

$$g_m = 2\sqrt{kI_D} = 2mS$$

b) Determinare $|G(0)|$ e $|G(\infty)|$

$|G(0)|$



$$i_D = g_m v_{GS}$$

$$V_{out} = i_D(R_1 + R_2) = g_m v_{GS}(R_1 + R_2)$$

$$v_{GS} = v_{in} - i_D(R1 + R2) = v_{in} - g_m v_{GS}(R1 + R2)$$

$$v_{GS}(1 + g_m(R1 + R2)) = v_{in}$$

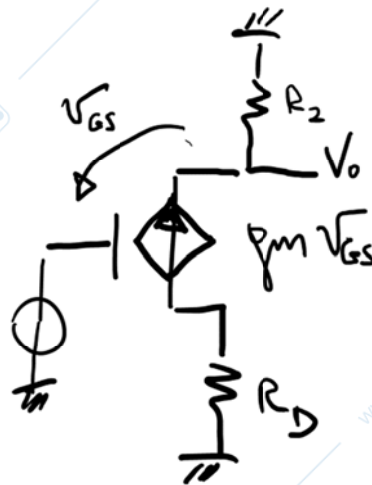
$$v_{GS} = \frac{v_{in}}{(1 + g_m(R1 + R2))}$$

$$V_{out} = g_m v_{GS}(R1 + R2) = g_m(R1 + R2) \frac{v_{in}}{(1 + g_m(R1 + R2))}$$

$$\frac{V_{out}}{v_{in}} = g_m(R1 + R2) \frac{1}{(1 + g_m(R1 + R2))} = 2mS \cdot 3k\Omega \frac{1}{1 + 2mS \cdot 3K\Omega} = \frac{6}{7}$$

$$|G(0)| = \frac{6}{7} = 0.857$$

$|G(\infty)|$



$$\frac{V_{out}}{v_{in}} = g_m R_2 \frac{1}{(1 + g_m(R2))} = 2mS \cdot 0.5k\Omega \frac{1}{1 + 2mS \cdot 0.5K\Omega} = \frac{1}{2}$$

$$|G(\infty)| = \frac{1}{2}$$

C) Frequenza di poli e zeri.

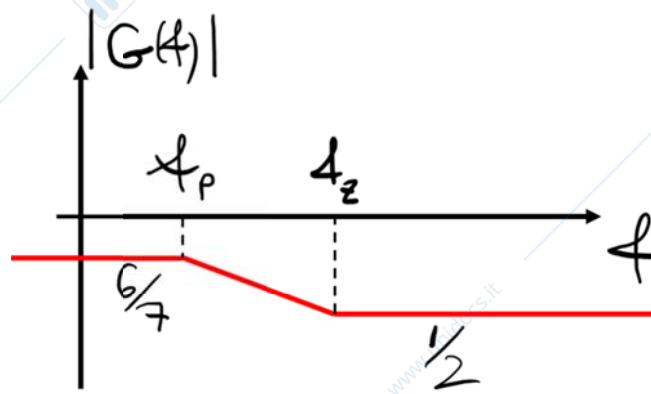
$$R_{eq} = R1 // (R2 + \frac{1}{g_m})$$

$$R_{eq} = 714\Omega$$

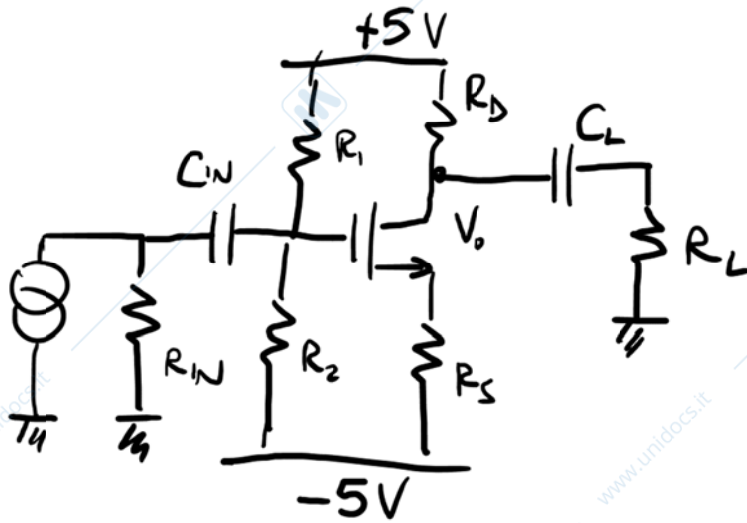
$$f_p = \frac{1}{2\pi R_{eq} C} = 2.2 \text{ kHz}$$

$$|G(0)|_{f_p} = |G(\infty)|_{f_z}$$

$$f_z = 2 * f_p * \frac{6}{7} = 3.78 \text{ kHz}$$



4)



$R_1 = 120 \text{ k}\Omega$

$R_2 = 80 \text{ k}\Omega$

$R_{in} = 144 \text{ k}\Omega$

$R_D = 1.5 \text{ k}\Omega$

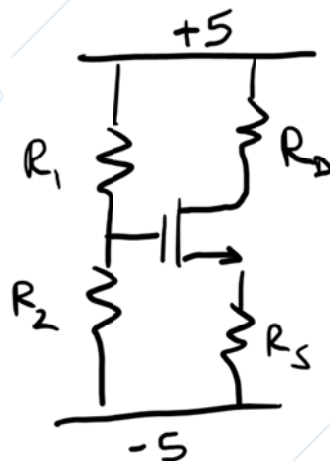
$C_{in} = 9 \text{ nF}$

$C_L = 47 \text{ uF}$

$V_{tn} = 1 \text{ V}$

$k_p = 500 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$

a) Determinare R_s tale per cui $I_d = 0.5 \text{ mA}$



HP: Saturazione

$$I_D = k(V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{I_D}{k_n}} = \sqrt{\frac{0.5 \text{ mA}}{\frac{500 \mu\text{A}}{\text{V}^2}}} = 1 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$V_G = \frac{5 \cdot 80 \text{ k}}{200 \text{ k}} + \frac{-5 \cdot 120 \text{ k}}{200 \text{ k}} = \frac{400 \text{ k} - 600 \text{ k}}{200 \text{ k}} = -1 \text{ V}$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = -1 - 2 = -3V$$

$$R_S = (V_S - (-5)) \frac{1}{I_D} = \frac{2}{0.5} = 4k\Omega$$

$$V_D = 5 - R_D I_D = 5 - 1.5k \cdot 0.5m = 4.25V$$

$$V_{D_S} = 7.25$$

Saturazione confermata

b) Considerando $R_S = 500$ e $I_D = 2mA$, Determinare $\left| \frac{I_{out}}{I_{in}} \right|$.

Calcoliamo prima di tutto la transconduttanza:

$$g_m = 2\sqrt{kI_D} = 2mS$$

Per quanto riguarda poli e zeri:

C_{in} introduce uno zero nell'origine e ha un polo in

$$f_{pin} = \frac{1}{2\pi C_{in} (R_{in} + R_1 || R_2)} = 92 Hz$$

C_L introduce uno zero nell'origine e ha un polo in

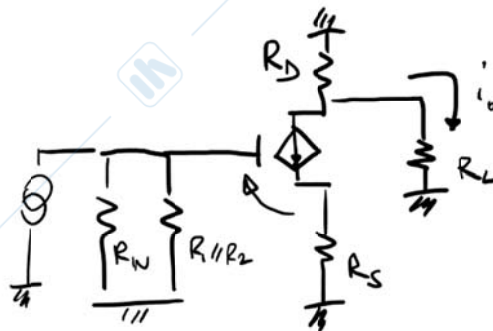
$$f_{pL} = \frac{1}{2\pi C_L (R_L + R_D)} = 1.7Hz$$

$|G(0)|$

A frequenza = 0, C_{in} e C_L si comportano come dei circuiti aperti.

$$\left| \frac{I_{out}}{I_{in}} \right| (0) = 0$$

$|G(\infty)|$



$$v_g = i_{in}(R_{in} || R_2 || R_1) = 36k i_{in}$$

$$v_{out} = -g_m v_{GS}(R_D || R_L)$$

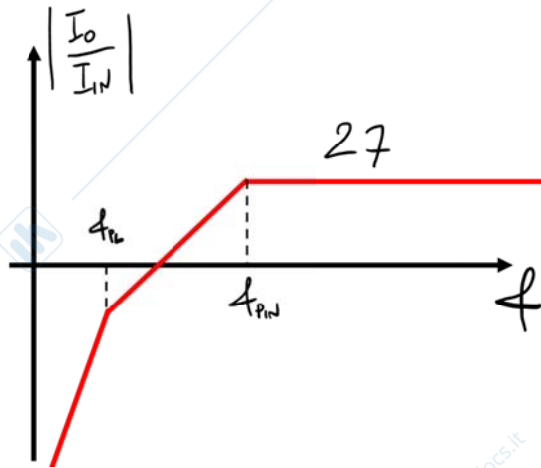
$$v_{GS} = \frac{v_g}{1 + g_m R_S}$$

$$V_{out} = -g_m(R_D || R_L) \frac{36k\Omega i_{in}}{1 + g_m R_S}$$

$$\frac{V_{out}}{i_{in}} = -g_m(R_D || R_L) \frac{36k\Omega}{1 + g_m R_S} = -2mS \cdot 375\Omega \frac{36k\Omega}{1 + 2mS \cdot 500\Omega} = -13.5 \frac{kV}{A}$$

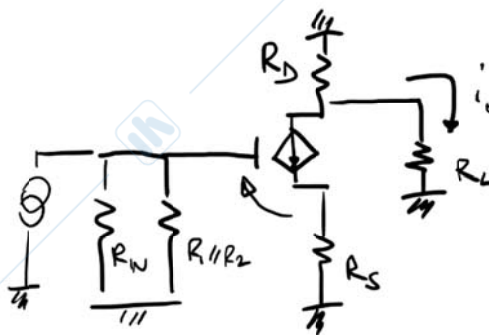
$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{V_{out}}{I_{in} R_L} = -27$$

$$\left| \frac{I_{out}}{I_{in}}(\infty) \right| = 27$$



c) Nel caso ad alta frequenza, calcolare il massimo valore della corrente applicabile in ingresso affinché la condizione di piccolo segnale per il MOS sia rispettata.

Affinché la condizione di piccolo segnale sia verificata, vogliamo che $v_{GS} \ll 2(V_{GS} - V_{tn})$



Nel nostro circuito,

$$v_g = i_{in}(R_{in} || R_2 || R_1) = 36k\Omega i_{in}$$

$$v_s = i_d R_s$$

$$i_d = g_m v_{gs}$$

Quindi possiamo calcolare v_{gs} come:

$$v_{GS} = v_g - v_s = v_g - i_d R_s = v_g - g_m v_{GS} R_s$$

$$v_{GS} = \frac{v_g}{1 + g_m R_s} = \frac{36k\Omega}{1 + g_m R_s} i_{in}$$

$$v_{GS} = \frac{36k\Omega}{1 + 2mS \cdot 500\Omega} i_{in} = 18k\Omega i_{in}$$

Quindi possiamo scrivere:

$$|v_{GS}| = 18k\Omega |i_{in}| \ll 2 * |V_{GS} - V_{tn}| = 2 * 1V = 2V$$

$$|i_{in}| \ll \frac{2V}{18k} = 111 \mu A$$

Per mantenere la condizione di piccolo segnale, vogliamo che

$$|i_{in}| < 11 \mu A$$